

ACRONIMI

A

AC: Alternating Current
ADD: Address
ADC: Analog-to-Digital Converter
ALE: Address Latch Enable
ALU: Aritmetic Logic Unit
AM: Amplitude Modulation
ANSI : American National Standards Institute
ASCII: American Standard Code for Information Interchange
ASIC: Application Specific Integrated Circuit
AV: Address Valid

B

BCD: Binary Coded Decimal
BIOS: Basic Input Output System
BJT: Bipolar Junction Transistor
BOR: Brown Out Reset

C

CAS: Column Address Strobe
CD: Compact Disc
CISC: Complex Instruction Set Computing
CLC: Configurable Logic Cell
CLE: Command Latch Enable
CMOS: Complementary MOS
COP: Computer Operating Properly
CPLD: Complex PLD
CPU: Central Processing Unit
CS: Chip Select
CSPAR: Chip Select Pin Assignment Register

D

DAC: Digital-to-Analog Converter
d.c.: duty cycle
DC: Direct Current
DDR SDRAM: Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
DIL: Dual In Line
DIP : Dual In-line Package
DMM: Digital Multi Meter
DSP: Digital Signal Processing
DTL: Diode Transistor Logic

E

E2PROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
ECL: Emitter Coupled Logic
EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

F

FET: Field Effect Transistor
FF D: Flip Flop Delay
FF RS: Flip Flop Reset Set
FF T: Flip Flop Toggle
FM: Frequency Modulation

FPGA: Field Programmable Gate Array

G

GAL: Gate Array Logic

H

HC: High speed CMOS

HD: Hard Disk (disco rigido)

I

IC: Integrated Circuit

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor

IORQ: I/O Request

IR: Instruction Register

IREM: Infra Red Emitting Diode

L

LCD: Liquid Cristal Display

LED: Light Emitting Diode

LIFO: Last In First Out

LS: Low power Schottky

LSB: Least Significant Bit

LSI: Large Scale Integration

M

MCLR: Master CLear

MOS: Metal Oxide Semiconductor

MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

MREQ: Memory REQuest

MSB: Most Significant Bit

MSI: Medium Scale Integration

N

NI: Noise Immunity

NM: Noise Margin

NTC: Negative Temperature Coefficient

O

OE: Output Enable

OST: Oscillator Startup Timer

OTP: One Time Programmable

P

PAL: Programmable Array Logic

PC: Program Counter

PE: Preset Enable

PIC: Peripheral Interface Controller

PIN (diodo): zona P, zona Intrinseco, zona N

PIN: Personal Identification Number

PISO: Parallel-In Serial-Out

PL: Parallel Load

PLA: Programmable Logic Array.

PLC: Programmable Logic Controller.

PLD: Programmable Logic Device.

PLL: Phase Locked Loop
POR: Power-On Reset
PROM: Programmable Read Only Memory
PWRT: PoWeR-up Timer

R

RAM: Random Access Memory
RAS: Row Address Strobe
RISC: Reduced Instruction Set Computing
RMS: Root Medium Square
ROM: Read Only Memory
RTD: Resistance Temperature Detector
RTL: Resistor Transistor Logic
R/W : Read / Write

S

SIPO: Serial Input Parallel Output
SP: Stack Pointer
SRAM: Static RAM
SSI: Small Scale Integration

T

TTL: Transistor Transistor Logic
TVL: Trip Voltage Level

U

ULSI: Ultra Large Scale Integration

V

VHDL: Very Hardware Description Language
VLSI: Very Large Scale of Integration

W

WDT: Watch-dog Timer

INDICE ANALITICO

A

- Algebra di Boole 214
- Alea statica 220
- Alimentatore 183
- Ammettenza 145
- Ampiezza 114
- Anodo 178
- AND
 - Porta (gate) 221
 - Prodotto logico 212
 - Wired-AND 226
- Armonica 118
- Assembler 315
- Astabile 270
 - Con NOT trigger 271
 - Con 555 272
 - Con quarzo 273
- Autoinduzione 88
- Automati
 - Asincroni 280
 - Descrizione 277
 - Sintesi sincroni 278
- Avvolgimento 183

B

- Banda passante 148
- Biot Savart (legge di) 81
- Bistabile 259
- Bit 230
- Bobina 85
- Boucherot teorema 157
- Buffer 226
- Bus
 - Controllo 309
 - Dati 309
 - Indirizzi 309
- Byte 300

C

- Campo
 - Elettrico 59
 - Magnetico 81
- Canale
 - N 194
 - P 195
- Capacità
 - Condensatore 58
 - Memoria 300

- Caratteristica
 - BJT 189
 - Diodo 178
- Generatore 16
 - Impedenza (caratteristica) 146
 - LED 42
 - Trigger 226
- Carica
 - Condensatore 63
 - Elettrica 10
 - Induttore 90
- Catodo 178
- Ciclo
 - Di isteresi 82
 - Di lavoro 58
 - Di lettura 303
 - Di scrittura 303
- Circuito
 - Clamper 186
 - Elettrico (rete) 13
 - Magnetico 84
 - Moltiplicatore 185
 - Protezione carico induttivo 186
 - Raddrizzatore 180
 - RC 66, 140
 - RL 143
 - RCL 147
 - Rilevatore fronti 186
- Clock 316
 - A più fasi 275
- Codice
 - ASCII 236
 - BCD 235
 - Binario 234
 - Decimale 235
 - Gray 235
 - Istruzione 318
 - Operativo 324
- Coefficiente
 - Di risonanza 148
 - Di temperatura 15
- Comparatore 230
- Condensatore
 - Carica, scarica di 61
 - Ceramico 60
 - Energia 69
 - In parallelo 61
 - In regime sinusoidale 137
 - In serie 61
 - In transitorio 151
 - Parametri 60
- Conduttanza 13, 145
- Contatore
 - Asincrono 264
 - Binari e BCD 265

- Contaeventi 267
- Cronometro 267
- Divisore di frequenza 267
- Espansione 266
- Frequenzimetro 267
- Generatore funzioni 275
- Modulo 264
- Johnson 267
- UP/DOWN 266
- Presettabile 266
- Sincroni 264
- Costante di tempo 62, 91

D

- Darlington 193
- Decibel 123
- Decoder 231
- De Morgan (teorema) 214
- Demultiplexer 229
- Diffusione 176
- Diafonia 146
- Diodo
 - Fotodiodo 180
 - LED 179
 - Laser 179
 - Polarizzazione 178
 - PIN 179
 - Schottky 179
 - Zener 178
- Drogaggio 175

E

- Edge triggered (flip flop) 260
- Encoder 230

F

- Fan-out 223
- Fase
 - Angolo 114
 - Fase di fetch 314
 - Fase di execute 314
- Filtro selettivo 150
- Flip Flop
 - Antirimbalo 262
 - D 260
 - JK 260
 - Start stop attuatore 261
 - T 261
 - Temporizzazione 260
- Flusso magnetico 82
- Forza
 - di Lorentz 85
 - Elettrodinamica 86

Elettromotrice 11, 86
Magnetomotrice 71
Foucault correnti di 77
Frequenza 47

G

Generatore
 Di corrente 16, 180
 Di tensione 16
Gibbs fenomeno 119
Giunzione PN 176

H

Hall effetto 176
Hopkinson legge 84

I

Immunità al rumore 223
Impedenza 141
Induttanza 88, 139
 Mutua 89
Induzione elettromagnetica 86
Isteresi magnetica 82
Istruzioni
 ADD 315
 INC 315
 LD 315
 Tempo di esecuzione 314

L

Lacune 174
Latch 258
Lenz (legge di) 87
Linea
 Modello elettrico 157
 Rendimento di linea 158
Livelli di tensione
 In ingresso 222
 In uscita 223
Lorentz forza 85

M

Maglia 31
Mappa di Karnaugh 218
Memoria
 Capacità 300
 Ciclo lettura e scrittura 303
 Elemento di 259
 E2prom e flash 302
 RAM statica 302
 RAM dinamica 304

- Seriale 305
- Modello
 - Atomo 10
 - A contatti 220
 - Bipolo 38
 - BJT 189
 - Thevenin 39
- Monostabile 270
 - Con NOR CMOS 272
 - Con '555' 272
 - Ritardato 276
- Multiplexer 228

- N
- NAND porta 214
- Nodo 32
- NOR porta 214
- NOT
 - Negazione logica 212
 - Porta logica 215

- O
- OR
 - Somma logica 212
 - Porta 215

- P
- Parametri
 - Condensatore 60
 - Porte logiche 222
 - Segnali 110
- Polarizzazione
 - Diodo 178
 - Transistor 188
- Porte di I/O 318
- Potenza
 - In continua 14
 - In regime sinusoidale 155
 - Porte logiche 224
- Punto di lavoro 41

- R
- Ramo 31
- Rappresentazione
 - Ampiezza 123
 - Con numeri complessi 115
 - Trigonometrica 114
 - Vettoriale 114
- Registri 263
- Registro
 - A/W 312
 - Indice 313

IR 312
PC 312
SP 313

Status 312

Reset

Circuito di 65
MCLR 317

Rete elettrica 31

Rifasamento 158

Rigidità elettrica 59

Riluttanza 84

Risonanza 148

RLC in transitorio 153

S

Segnale

Alternato 58

Analogico 211

A valor medio nullo 58

Digitale 211

Misto 58

Pulsante 57

Periodico 57

Spettro 107

Unipolare 57

Valore efficace 110

Valore medio 110

Semiconduttori 174

Serie di Fourier 117

Sommatore 230

Sostanza

Diamagnetica 82

Ferromagnetica 82

Paramagnetica 82

Sottocubo 218

T

Tabella

Combinazioni 211

Stati 277

Tempo

Commutazione 224

Di accesso 300

propagazione 224

Tensione

Concetto 10

Ingresso 222

Uscita 223

Thevenin (teorema) 37

Transistore

BJT 187

MOS 194

Transitorio 62, 92

Trasformatore 181
Trigger ingresso 226
TTL 225

U

Uscita

Open drain 226
3-state 227

V

Valore efficace 110

Velocità potenza prodotto 225

Verilog 307

Verso corrente 33

Vettore 114

VHDL 307

Z

Zener 178